

半導体を中心とする電子デバイスのプロセス技術において、材料表面を清浄化・改質する技術はデバイス界面の信頼性に対して極めて重要である。また、ウェットプロセスを用いた新規なエッチングや薄膜を形成する技術は、デバイスの微細化・三次元化のひとつのテクノロジードライバである。本研究会は界面ナノ現象を明らかにすることでウェットプロセスに関する学問を構築し、次世代へと教育できる環境を整えている。同時に本研究会成果物の実行者である若手の主体性が極めて重要であることから、若手の主体性強化を目的としたポスター発表展を2015年より企画している。若手技術者とベテラン技術者とのFace to faceの活発な議論を期待して、下記の要項で第4回ポスター展を開催する。

若手のポスター発表展 ーベテランとの議論に打ち勝て！ー

- 主催：応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会
- 実行委員長：安藤景太（慶應義塾大学）
- 実行委員：真田俊之（静岡大学），岩元 勇人（ソニーセミコンダクターソリューションズ），吉水康人（東芝メモリ），萩本 賢哉（ソニーセミコンダクターソリューションズ），矢野大作（オルガノ），荒木浩之（SCREENセミコンダクターソリューションズ），川上雅之（オルガノ），吉田勇喜（関東化学），永淵琢也（日本インテグリス）

■ 日時：2019年3月11日（月） 13：00～17：30

■ 場所：慶應義塾大学 日吉キャンパス（来往舎）
（〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1）

■ 参加費：2000円
※ただし、事前に参加のお申込みをお願い致します。

■ 申込締切：2019年3月5日（火）

■ 定員：60名 ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください。

■ プログラム：開会の辞・司会進行

- (1) 13：00～13：10 「開会の辞」 企画：川上雅之（オルガノ）
- (2) 13：10～14：10 「2分間ショートプレゼン」
14：10～14：25 （休憩・会場準備）
- (3) 14：25～16：40 「ポスターセッション」
- (4) 16：40～17：00 「INE活動報告」総務責任者：吉水康人（東芝メモリ）
- (5) 17：00～17：10 「表彰」 副委員長：岩元 勇人（ソニーセミコンダクターソリューションズ）
- (6) 17：10～17：20 「閉会の辞」 実行委員長：安藤 景太（慶應義塾大学）
- (7) 17：20～17：30 「写真撮影」
- (8) 18：00～20：00 「懇親会（カサロス）」（会場：BRITISH PUB HUB慶應日吉店）

■ 参加の申込方法：

URLもしくはQRコードより、アンケートにご回答する形でお申し込みをお願い致します。

<https://goo.gl/forms/rHmATQFLxIgf1oCy2>

アクセス不具合等ございましたら、メールにてお申込みのお願い致します。

日本インテグリス合同会社 永淵琢也 takuya.nagafuchi@entegris.com

参加申込書（ポスター展、カサロス共通です。）
<https://goo.gl/forms/rHmATQFLxIgf1oCy2>



タイトル	発表者	所属
1 高圧マイクロジェット洗浄における帯電防止技術	瀬川 大司	愛知工業大学
2 PSL粒子を用いた超音波洗浄評価技術	澤木 良河	愛知工業大学
3 微小パーティクル洗浄におけるブラシ洗浄技術の開発	濱田 崇広	芝浦メカトロニクス株式会社
4 機能水によるCo溶解抑制洗浄	杉田 航	栗田工業株式会社
5 金属除去膜でのろ過による有機溶媒精製およびそのメカニズムに関して	三浦 こずえ	日本インテグリス合同会社
6 有機溶媒中の基板に対する添加剤の吸着挙動	大日向 秀収	野村マイクロ・サイエンス株式会社
7 PTFEフィルターと低脈動ポンプを使用した高温硫酸中の粒子低減	高倉 知征	日本ポール株式会社
8 洗浄プロセスにおけるUV技術の応用	片桐 勇志	東京エレクトロン九州株式会社
9 加湿大気中での吸着水/KBr(001)界面の周波数変調原子間力顕微鏡観察	大江 弘晃	金沢大学
10 高電子移動度トランジスタの閾値制御に向けた低損傷・高精度エッチング技術の検討	小松 祐斗	北海道大学
11 HfO ₂ 強誘電体トンネル接合メモリのサイクル不良メカニズムの解明	山口 まりな	東芝メモリ株式会社
12 WET処理におけるIII-V族化合物半導体の表面反応メカニズム解析（水による影響）	西尾 賢哉	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
13 GaN 多孔質構造にみられる電界依存光吸収特性を利用した局在的電気化学反応制御の検討	渡久地 政周	北海道大学
14 GaNの選択的光電気化学エッチング	島内 道人	北海道大学
15 Si上のIII-Vナノワイヤ選択成長とトランジスタ作製	蒲生 浩憲	北海道大学
16 表面変質層を用いたITO加工メカニズム解明とサイクル加工への応用	平田 瑛子	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
17 MacEtchを用いた垂直孔形成における添加剤の効果	花谷 俊輔	関西大学
18 自己組織Agナノワイヤをテンプレートとした化学エッチングによるSi表面上のナノ溝構造	増本 晴文	大阪大学
19 塗布型拡散剤を用いたnm領域へのコンフォーマルドーピング技術	真下 峻一	東京応化工業株式会社
20 エレクトロスプレー製膜による有機薄膜太陽電池の活性層膜表面の評価	丹菊 大輝	愛知工業大学

第26回カサロス (懇親会)

■主催：応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会

■日時：2019年3月11日（月） 18：00～20：00

■場所：（慶應義塾大学 日吉キャンパス 協生館 1階）
（〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1）

《交通》日吉駅（東急東横線、東急目黒線／横浜市営地下鉄グリーンライン）徒歩1分



カサロス会場
HUB

②④ 協生館1階

ポスター会場
⑨ 来往舎

参加申込書（ポスター展、カサロス共通です。）
<https://goo.gl/forms/rHmATQFLxIgf1oCy2>

■参加費：5,000円 当日参加7,000円（学生 無料）

※カサロス会費について当日会場にてお支払い下さい。
領収書を発行します。

■申込締切：2019年3月5日（火）

■定員：70名 ※昨年より定員が増えました。

■参加の申込方法：

URLもしくはQRコードより、アンケートにご回答する形でお申し込みをお願い致します。

<https://goo.gl/forms/rHmATQFLxIgf1oCy2>

アクセス不具合等ございましたら、メールにてお申込みのお願い致します。

日本インテグリス合同会社 永瀧琢也 takuya.nagafuchi@entegris.com

